Komunikat prasowy

Podczas wydarzenia KIOXIA Forum firma KIOXIA zaprezentuje technologię XL-FLASH 3. generacji – bardzo wydajną pamięć flash nowej generacji charakteryzującą się niskimi opóźnieniami, stworzoną z myślą o AI

Prototyp osiąga średnie opóźnienie odczytu na poziomie 3 mikrosekund



Niemcy, Düsseldorf, 25 listopada 2026 r. – KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś, iż podczas KIOXIA Forum w Tokio, zaplanowanego na 26 listopada 2026 r., KIOXIA Corporation zaprezentuje prototyp technologii XL-FLASH™ 3. generacji – nowej generacji pamięci flash charakteryzującej się niskimi opóźnieniami i wysoką wydajnością, przeznaczonej do zastosowań związanych z AI.

XL-FLASH™ charakteryzuje się znacznie krótszym czasem odczytu i większą trwałością zapisu niż standardowa pamięć flash NAND. Technologia ta jest opracowywana z myślą o stworzeniu nowej warstwy pamięci, która wypełni lukę między pamięcią masową a pamięcią DRAM pod względem wydajności, pojemności i kosztów.

Pamięć XL-FLASH™ 3. generacji wykorzystuje technologię CBA (CMOS directly Bonded to Array), stanowiącą jedną z kluczowych cech pamięci flash 3D KIOXIA BiCS FLASH™. Dzięki temu oferuje około 70% większą gęstość bitową niż pamięć XL-FLASH™ 2. generacji, zachowując jednocześnie wysoką wydajność.

Średnie opóźnienie odczytu wynosi zaledwie 3 mikrosekundy, czyli mniej niż jedną dziesiątą wartości osiąganej przez pamięci KIOXIA BiCS FLASH™ 8. generacji typu TLC[1]. Ponadto efektywność energetyczna odczytu danych w jednostkach 512 bajtów wzrosła o około 135% w porównaniu z pamięcią XL-FLASH™ 2. generacji[2]. Wysyłka próbek do wybranych klientów w celu przeprowadzenia oceny funkcjonalnej jest planowana na marzec 2027 r.

Rozwój aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych, w tym rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, doprowadził do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na pamięć o dużej pojemności w systemach obliczeniowych. Jednak wykorzystanie pamięci DRAM do przechowywania większości danych wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi pojemności, kosztów i zużycia energii. Wykorzystując niskie opóźnienia odczytu i wysoką efektywność energetyczną pamięci XL-FLASH™, nowe architektury systemowe mogą optymalizować sposób przechowywania danych w zależności od częstotliwości dostępu i wymagań dotyczących wydajności. Pozwala to uzupełnić pamięć DRAM lub zastąpić jej część pamięcią flash.

„Wraz z dalszym rozwojem sztucznej inteligencji rośnie zapotrzebowanie na pamięć o coraz większej pojemności. Opisywane podejście pozwoli sprostać tym wymaganiom, jednocześnie obniżając całkowity koszt posiadania (TCO) serwerów AI, centrów danych oraz szerokiej gamy innych rozwiązań” – powiedział Axel Störmann, wiceprezes i dyrektor ds. technologii w KIOXIA Europe GmbH.

KIOXIA będzie kontynuować prace nad rozwojem technologii XL-FLASH™, dążąc do jej zastosowania w szerokiej gamie produktów, w tym w dyskach SSD oferujących wysoką wydajność mierzoną liczbą operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz modułach rozszerzenia pamięci obsługujących standard Compute Express Link (CXL). W ten sposób KIOXIA zamierza stworzyć nową warstwę pamięci, która wypełni lukę między pamięcią DRAM a tradycyjnymi nośnikami danych.

###

Uwagi:

1: Porównanie opóźnień odczytu na podstawie pomiarów przeprowadzonych dla pamięci TLC o pojemności 1 Tb z serii KIOXIA BiCS FLASH™ 8. generacji oraz prototypu XL-FLASH™ 3. generacji. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez KIOXIA.

2: Porównanie efektywności energetycznej operacji odczytu 512-bajtowych bloków danych dla pamięci XL-FLASH™ 2. generacji i prototypu XL-FLASH™ 3. generacji. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez KIOXIA.

Poniższe znaki towarowe, znaki usługowe i/lub nazwy firm – Compute Express Link, CXL oraz Compute Express Link Consortium, Inc. – nie są własnością KIOXIA Europe GmbH ani spółek należących do grupy KIOXIA i nie zostały przez nie zgłoszone, zarejestrowane ani utworzone. Mogą być jednak stosowane, rejestrowane, tworzone lub być w posiadaniu osób trzecich w różnych jurysdykcjach, a zatem mogą być chronione przed nieautoryzowanym użyciem.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym ceny i specyfikacje produktów, treść usług i dane kontaktowe, są aktualne w dniu podania ich do wiadomości i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH jest europejską spółką zależną KIOXIA Corporation, czołowego na świecie dostawcy pamięci flash i dysków stałych (SSD). Od czasu wynalezienia pamięci flash NAND po dzisiejsze cieszące się uznaniem technologie pamięci flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA nadal jest pionierem innowacyjnych rozwiązań i usług w zakresie pamięci, które wzbogacają życie ludzi i poszerzają horyzonty społeczeństwa. Innowacyjna technologia pamięci flash 3D BiCS FLASH™ tej firmy kształtuje przyszłość pamięci masowej w zastosowaniach wymagających dużej gęstości zapisu, w tym w zaawansowanych smartfonach, komputerach osobistych, systemach motoryzacyjnych, centrach danych oraz systemach generatywnej sztucznej inteligencji. **Odwiedź naszą stronę internetową KIOXIA**

Dane kontaktowe do publikacji:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Niemcy

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@eu.kioxia.com

Dane kontaktowe w przypadku pytań dot. publikacji:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Wydawca:

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tel: +49 (0)172 617 8431

E-mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Strona internetowa: www.pretzl.com